



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ» (АО «НИИПП»)

✉ Россия, 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а, ИНН/КПП 7017084932/701701001
☎ + 7 (3822) 288-288 (приемная), факс +7 (3822) 55-50-89
E-mail: niipp@niipp.ru www.niipp.ru

21.02.2015 № 1086
На № 04.01.01-270 от 17.02.2025

Заместителю генерального
директора по научной работе
ФТИ им. А.Ф. Иоффе
Брункову П.Н.

О ведущей организации по
диссертации

Заведующему лабораторией
фотоэлектрических
преобразований
Шварц М.З.

Уважаемый Павел Николаевич!
Уважаемых Максим Зиновьевич!

Настоящим сообщаем о том, что АО «НИИПП» готово выступить в качестве ведущей организации по работе «Модификация оптических и резистивных свойств каскадных АЗВ5 фотоэлектрических преобразователей и AlGaAs/GaAs светоизлучающих диодов», представляемой научным сотрудником лаборатории фотоэлектрических преобразователей Малевской Александрой Вячеславовной на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности «физика полупроводников (1.3.11)».

Также направляем перечень публикаций АО «НИИПП», соответствующий научному направлению диссертационной работы А.В. Малевской (Приложение 1).

Приложение: 1. на 2 л. в 1 экз.

С уважением,

Заместитель генерального директора по
научной работе

А.В. Васильев

 Майбах Максим Сергеевич, 110 отдел, Инженер-конструктор
тел.: +7 (3822) 288-200, majbah_ms@niipp.ru

1022-2025

**Сведения об основных публикациях ведущей организации
АО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов»,
(НИИПП, г. Томск, Россия)
по специальности диссертации соискателя Малевской А.В.
в научных журналах за последние 5 лет.**

1. Торхов Н.А. Электрические характеристики истинно одномерных 1d-контактов металл-полупроводник с барьером Шоттки. в сборнике: Мокеровские чтения. 15-я международная научно-практическая конференция по физике и технологии наногетероструктурной свч-электроники: сборник трудов. Москва, 2024. С. 55-56.
2. Бекезина Т.П., Вайсбеккер М.С., Бурмистрова В.А., Божков В.Г. Электрохимическое осаждение иридия на арсенид галлия из сульфатного электролита на основе гексахлориридиевой (iv) кислоты. Журнал прикладной химии. 2023. т. 96. № 12. с. 980-993.
3. Божков В.Г., Бекезина Т.П., Бурмистрова В.А. Диоды с барьером Шоттки на основе термостойких контактов Ir-GaAs и Pt/Ir-GaAs, созданных электрохимическим осаждением. Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 2022. т. 25. № 1. с. 48-52.
4. Torkhov N.A., Gradoboev A.V., Orlova K.N., Toropov A.S. Physical nature of size effects in TiAlNiAu/GaN ohmic contacts to AlGaIn/GaN heteroepitaxial structures. Semiconductor science and technology. 2022. т. 37. № 5. с. 055023.
5. Шевчук А.А., Двирный В.В., Майбах М.С., Санько С.А., Павлова А.А. Разработка светодиодной сборки имитатора внеатмосферного солнечного излучения. В сборнике: Решетневские чтения. Материалы XXVI международной научно-практической конференции, посвященной памяти генерального конструктора ракетно-космических систем академика М. Ф. Решетнева. Красноярск, 2022. с. 412-414.
6. Павлова А.А., Санько С.А., Хотненко Ю.А. Разработка и исследование оптических термостабильных компаундов МФ ТЭ-1, ТЭ-2, ТЭ-3. силиконовые заливочные компаунды, наработка, термоциклирование. Научный журнал «Архивариус». 2021. т. 7 #5(59). с. 19-25.
7. Торхов Н.А., Клещенко М.С., Новиков В.А., Будняев В.А. Физические механизмы функционирования низкотемпературных AuNi/N+-Si омических контактов. В книге: Мокеровские чтения. 12-я международная научно-практическая конференция по физике и технологии наногетероструктурной СВЧ-электроники. Москва, 2021. с. 33-34.
8. Градобоев А.В., Бондаренко Е.А., Варлачев В.А., Емец Е.Г., Седнев В.В. Методика исследования стойкости светодиодов к облучению быстрыми нейтронами на реакторе ИРТ-Т. Приборы и техника эксперимента. 2021. № 4. с. 129-132.
9. Градобоев А.В., Орлова К.Н., Симонова А.В., Седнев В.В. Имитация различных внешних воздействий на светодиоды схемным моделированием объемных каналов утечки тока. Приборы и техника эксперимента. 2021. № 5. с. 90-99.

10. Градобоев А.В., Бондаренко Е.А., Варлачев В.А., Емец Е.Г., Седнев В.В. Исследование стойкости светодиодов на основе гетероструктур AlGaAs к облучению быстрыми нейтронами на ректорах БАРС-4 и ИРТ-Т. Вопросы атомной науки и техники. Серия: физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. 2021. № 1. с. 29-32.